

Oeabt 提供一系列自由空间和光纤耦合偏置探测器。支持探测波长范围从150-1800nm的光束,基本覆盖了实验室常用光源的光谱范围。其中采用磷化镓光电感应器件对150-500nm波段敏感,硅光电及锗光电感应器件则分别300-1100nm及800-1800nm波段有连续可供监测的偏置电流输出。对这些电流进行采集和分析,可以为激光和红外测距、遥感、流体分析、传感器等应用产品提供数据和算法基础。



### 偏置探测器

- ▶ 适用于激光和红外测距、遥感、流体分析、传感器等应用;
- ▶ 可检测波长范围:150nm-1800nm;
- ▶ 磷化镓光电感应器件对150nm-500nm波段敏感,硅光电及锗光电感应器件则分别300nm-1100nm及800nm-1800nm波段有连续可供监测的偏置电流输出;

产品型号	PDA-GO	开/关形式	滑动开关
探测器类型	锗光电型	电池检查开关	瞬时按钮
活动区	Ø5.0 mm (19.6mm <sup>2</sup> )	输出	BNC (直流耦合)
波长范围	800 ~ 1800 nm	包装尺寸	46*60*20mm
峰值波长	1550 nm	PD表面深度	2.2 mm
峰值响应 <sup>2</sup>	0.85 A/W (典型值)	重量	100g
分流电阻	4 kΩ (典型值)	配件	SM1T1 耦合器 SM1RR 挡圈
结电容	4000 pF (Max)	储存温度	-20 ~ 70°C
上升时间(1310nm)	455 纳秒 (典型值)	工作温度	10 ~ 50 °C
NEP (λ p)	4.0 x 10 <sup>-12</sup> W/√Hz (典型值)	电池	A23, 12 VDC, 40 mAh
偏压	5V	VOUT (Hi-Z)	~9V
暗电流	40 μA (典型值), 80 μA (最大值)	VOUT (50 Ω)	~170 mV
输出电流	0 ~ 10 mA		

产品型号	PDA-GP	开/关形式	滑动开关
探测器类型	磷化镓偏置探测器	电池检查开关	瞬时按钮
有效探测区域	2.2 mm*2.2 mm (4.8mm <sup>2</sup> )	输出	BNC (直流耦合型)
波长范围	150 ~ 550 nm	包装尺寸	46*60*20mm
峰值波长	430 nm (典型值)	PD表面深度	2.2 mm
峰值响应 <sup>2</sup>	0.12 A/W (典型值)	重量	100g
分流电阻	100 GΩ (典型值)	配件	SM1T1 耦合器 SM1RR 挡圈
结电容	500 pF (典型值)	储存温度	-20 ~ 70°C
上升时间 (405 nm)	55 纳秒 (典型值)	工作温度	10 ~ 50 °C
NEP (λ p)	1.3 x 10 <sup>-14</sup> W/√Hz (典型值)	电池	A23, 12 VDC, 40 mAh
偏压	5V	输出电压 (高阻抗)	~9V
暗电流	40 pA (最大值)	输出电压 (50 Ω)	~170 mV
输出电流	0 ~ 5 mA		

产品型号	PDA-GP	开/关形式	滑动开关
探测器类型	硅光电偏置型	电池检查开关	瞬时按钮
有效区域	3.6 mm*3.6 mm (13 mm <sup>2</sup> )	输出	BNC (直流耦合)
波长范围	350 ~ 1100 nm	包装尺寸	46*60*20mm
峰值波长	970nm	PD表面深度	2.2 mm
峰值响应	0.65 A/W	重量	100g
分流电阻	1 GΩ (典型值)	配件	SM1T1 耦合器 SM1RR 挡圈
结电容	40 pF (典型值)	储存温度	-20 ~ 70°C
上升时间 (632 nm)	14 ns (典型值)	工作温度	10 ~ 50 °C
NEP (λ p)	1.6 x 10 <sup>-14</sup> W/√Hz (典型值)	电池	A23, 12 VDC, 40 mAh
偏压	10V	VOUT (Hi-Z)	~9V
暗电流	0.35 nA (典型值), 6.0 nA (最大值)	Vout (50 Ω)	~170 mV
输出电流	0 ~ 10 mA		

注:除非另有说明,所有测量均在 25 °C 环境温度下进行。